

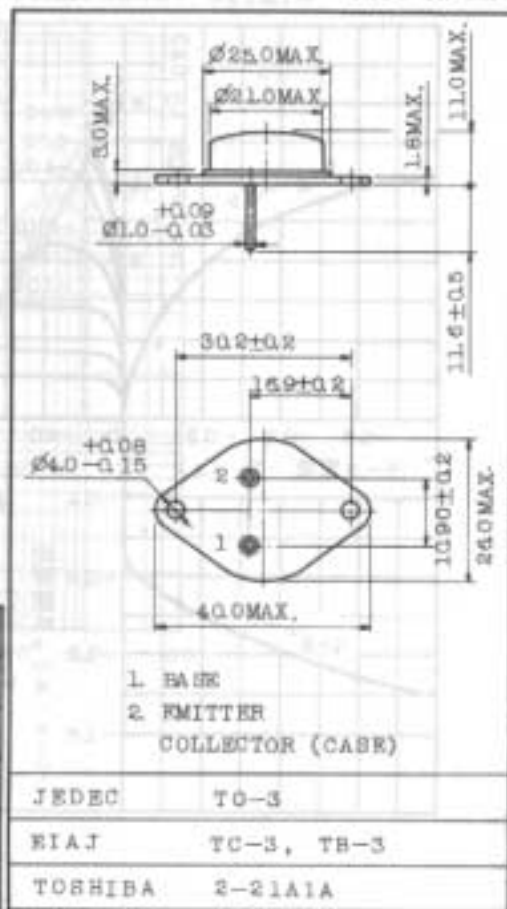
シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

2SB645

○ (電力増幅用 AC10V 以下) 50V - 51 Unit in mm

○ Power Amplifier Applications.

- ・ 高耐圧です。: $V_{CE0} = -200V$
- ・ トランジション周波数が高い。: $f_T = 12MHz$ (Typ.)
- ・ 2SD665 とコンプリメンタリになります。
- ・ 200W ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。
- ・ Complementary to 2SD665.
- ・ Recommended for 200W High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.



最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-200	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-200	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-15	A
エミッタ電流	I_E	15	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	150	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゝ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$	-	-	-100	μA
エミッタしゝ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	-	-	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -0.1A, I_B = 0$	-200	-	-	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -10mA, I_C = 0$	-5	-	-	V
直電流増幅率	h_{FE} (Note)	$V_{CE} = -5V, I_C = -1A$	40	-	140	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -5A, I_B = -0.5A$	-	-	-20	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -5A$	-	-	-1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10V, I_C = -1A$	-	12	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	-	450	-	pF

Note: h_{FE} 区分/ h_{FE} classification R: 40~80, O: 70~140